

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
28. Oktober 2021 (28.10.2021)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2021/213827 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

B24B 37/08 (2012.01) *B24B 37/10* (2012.01)
B24B 37/04 (2012.01) *B24B 55/02* (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2021/059415

(22) Internationales Anmeldedatum:
12. April 2021 (12.04.2021)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
20170996.1 23. April 2020 (23.04.2020) EP

(71) Anmelder: **SILTRONIC AG** [DE/DE]; Einsteinstr. 172,
Tower B / Blue Tower, 81677 München (DE).

(72) Erfinder: **KERSTAN, Michael**; Bachstr. 44, 84489 Burg-
hausen (DE). **OBERHANS, Stephan**; Sunthaimerstr. 6,
83119 Obing (DE). **WEISS, Robert**; Frauenbühlstraße 41,
84543 Winhöring (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY,
BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM,
DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH,
KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA,
MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI,
NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU,
RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM,
ZW.

(54) Title: METHOD FOR GRINDING SEMICONDUCTOR WAFERS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM SCHLEIFEN VON HALBLEITERSCHEIBEN

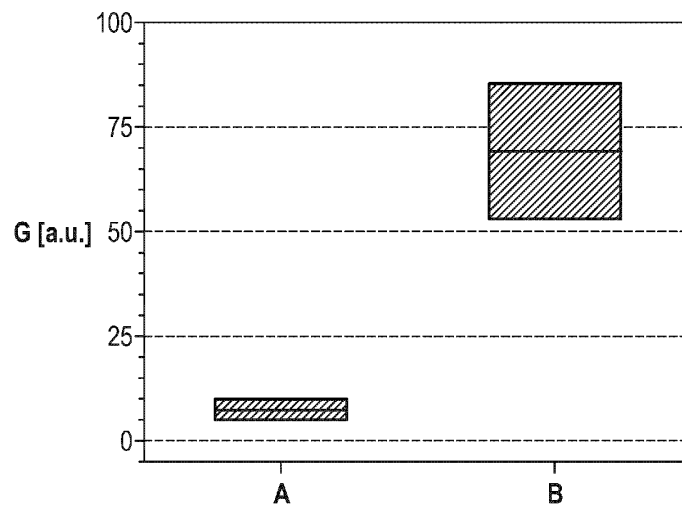


Fig. 1

(57) **Abstract:** The invention relates to a method for grinding a semiconductor wafer, in which the semiconductor wafer is machined for material removal by means of a grinding tool containing grinding teeth having a height h , with a cooling medium being fed into a contact region between the semiconductor wafer and the grinding tool, and, at any time during the grinding, a rinsing liquid is applied to a region on one side of the semiconductor wafer by means of a nozzle, characterised in that the distance between the region and the centre of the semiconductor wafer is not less than 2 mm and not greater than 10 mm.

(57) **Zusammenfassung:** Verfahren zum Schleifen einer Halbleiterscheibe, wobei die Halbleiterscheibe mittels eines Schleifwerkzeugs enthaltend Schleifzähne mit einer Höhe h unter Zuführung eines Kühlmediums in einen Kontaktbereich zwischen Halbleiterscheibe und dem Schleifwerkzeug Material abtragend bearbeitet werden, wobei zu jedem Zeitpunkt des Schleifens eine Spülflüssigkeit auf einen

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)